# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-338838

(43)Date of publication of application: 07.12.2001

(51)Int.Cl. H016 4/40 H01C 7/00

HOTC 7/00 HOTC 13/00 HOTF 27/00 HOTG 4/12 HOTG 4/30 HO3B 5/04 HO3B 5/12 HO3H 5/02

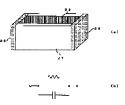
(21)Application number : 2000-155584 (22)Date of filing : 26.05.2000 (71)Applicant : SHARP CORP (72)Inventor : TSUDA YOIGHI

(54) MULTI-FUNCTIONAL ELECTRONIC PARTS, ITS MANUFACTURING METHOD, AND VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR EQUIPPED THEREWITH

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide multi-functional electronic parts composed of a plurality of packaging parts fulfilling different electrical functions and a voltage—controlled oscillator the substrate area of which can be reduced by mounting the parts.

SOLUTION: The multi-functional electronic parts in which a resistor and a capacitor are connected in parallel between conductor electrodes 22 and 23 for mounting are constituted by providing resistors 24 on the surfaces of insulating layers except the surfaces on which the electrodes 22 and 23 are provided in a chip type capacitor 21 provided with the electrodes 22 and 23 on its facing surfaces. When such electronic parts are connected to the emitter electrode of a transistor for socillating the voltage-controlled oscillator, the number of parts constituting the oscillator can be reduced by one as compared with the conventional example.



#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公開番号 特綱2001-338838 (P2001-338838A) (43) 公曜日 平成13年12日7日(2001 12 7)

				(***)		, AMERICA   18073 .	H (0001111111)	
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			f-73-ト*(参考)		
H01G	4/40		H01	C 7/00		H	5 E 0 0 1	
H01C	7/00			13/00		С	5 E O 3 3	
	13/00		H01	G 4/12		346	5 E O 7 O	
H01F	27/00			4/30		301F	5 E 0 8 2	
H01G	4/12	346				311D	5 J 0 2 4	
			審査請求 未請求	請求項の数12	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く	

(21)出顯番号	特願2000-155584(P2000-155584)
(22) 占城日	平成12年5月26日(2000. 5. %)

(71) 出頭人 000005049 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 (72)発明者 津田 陽一

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代單人 100085501 弁理士 佐野 静夫

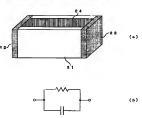
最終頁に続く

## (54) [発明の名称] 複合機能電子部品、その製造方法、及びこの複合機能電子部品を備えた電圧制御発振器

#### (57)【要約】

【課題】本発明は、複数の異なる電気機能の実装部品を 1つの電子部品として構成された複合機能電子部品と、 この複合機能電子部品が搭載されることによって、その 基板面積を小さくすることができる電圧制御発振器とを 提供することを目的とする.

【解決手段】対向する2面に実装用導体電極22,23 が設けられたチップ型コンデンサ21において、実装用 導体電極22,23の設けられた面以外の絶縁層表面 に、抵抗体24を設けることによって、実装用導体電極 22、23間に抵抗とコンデンサが並列に接続された複 合機能電子部品を構成することができる。このような複 合機能電子部品を、例えば、電圧制御発振器の発振用の トランジスタのエミッタ電極に接続することで、従来に 比べて、電圧制御発振器を構成するための部品点数を1 点削除することができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部と電気的に接続するための第1実装 用導体電極及が第2実装用導体電極と、前記第1実装用 導体電極のみと電気的及び物理的に接続された複数の第 1等電体層と、前記第2実装用導体電極のみと電気的及 び物理的に接続された複数の第2導電体層と、前記を第 及び第2端電機間及びその周囲を覆う絶数に されるとともに、前記第1 非電体層と前記第2端電体層 が前記的起導を挟んで安互に形成された積層とラミック コンデンサと

該種層セラミックコンデンサにおける前記第1及び第2 実装用導体電極の形成されていない前記絶縁層の表面に 形成されるととともに、前記第1及び第2実装用導体電 極と電気的及び物理的に接続された抵抗体と、

を有することを特徴とする複合機能電子部品。

【請求項2】 前記複合機能電子部品の形状が、直方体 形状であるとともに、

対向する2面に前記第1及び第2実装用導体電極が形成され、

該第1及び第2実装用導体電極が形成された2面以外の 4面のうちの少なくとも1面の前記絶縁層の表面に、前 記抵抗体が形成されることを特徴とする請求項1に記載 の複合機能電子部品。

【請求項3】 抵抗機能と容量機能を有する複合機能電 子部品の製造方法において、

第1 導電体層と第2 導電体層の間及びその周囲に絶縁層 が形成されるように、前記第1及び第2 導電体層及び前 記絶縁層が順に積層された後、

周囲に形成された前記絶縁層の表面上に抵抗体が形成さ れ...

前記第1導電体層及び前記抵抗体に電気的及び物理的に 接続されるように、外部と電気的に接続するための第1 実装用導体電極が形成されるとともに、

前記第2導電体層及び前記抵抗体に電気的及び物理的に 接続されるように、外部と電気的に接続するための第2 実装用導体電極が形成されることを特徴とする複合機能 電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記複合機能電子部品が形成された後、 前記複合機能電子部品のアドミッタンスが測定され、

測定したアドミッタンスの実数値より抵抗部分の抵抗値が輸出されるとともに

測定したアドミッタンスの虚数値より容量部分の容量値 が検出されることを特徴とする請求項3に記載の複合機 能電子部品の製造方法。

【請求項51 外部と電気的に接続するための第1実装 用海体電極及び第2実装用導体電極と、前記第1実装用 導体電極のみと電気的及び物理的に接続された複数の第 1等電体順と、前記第2架使用導体電極のみと電気的及 び物理的に接続された複数の第2準電体層と、前記第1 及び第2端を機関及びその周距を覆う終後間とで構成 されるとともに、前記第1等電体層と前記第2導電体層 が前記絶縁層を挟んで交互に形成された積層セラミック コンデンサと

該積層セラミックコンデンサにおける前記第1及び第2 実装用導体電極の形成されていない前記絶縁層の表面 に、抵抗値の低い導体材料で形成されるととともに、前 記第1及び第2票装用導体電極と電気的及び物理的に接 続されなインダクタンスパターンと、

を有することを特徴とする複合機能電子部品。

【請求項6】 前記複合機能電子部品の形状が、直方体 形状であるとともに、

対向する2面に前記第1及び第2実装用導体電極が形成 され、

該第1及び第2実装用導体電極が形成された2面以外の 4面のうちの少なくとも1面の前記絶縁層の表面に、前 記インダクタンスパターンが形成されることを特徴とす る請求項5に記載の複合機能電子部品。

【請求項7】 抵抗機能と容量機能を有する複合機能電 子部品の製造方法において、

第1導電体層と第2導電体層の間及びその周囲に絶縁層 が形成されるように、前記第1及び第2導電体層及び前 記絶縁層が順に積層された後、

抵抗率の低い導体材料によって、周囲に形成された前記 絶緑層の表面上に、インダクタンスパターンが形成さ れ、

前配第1 導電体層及び前記インダクタンスパターンに電 気的及び物理的に接続されるように、外部と電気的に接 続するための第1 実装用導体電極が形成されるととも に、

前記第2導電体層及び前記インダクタンスパターンに電 気的及び物理的に接続されるように、外部と電気的に接 続するための第2実装用導体電極が形成されることを特 微とする接金機能電子都品の製造方法。

【請求項8】 前記複合機能電子部品が形成された後、 前記複合機能電子部品の共振周波数が測定されることを 特徴とする請求項7に記載の複合機能電子部品の製造方 注

【請求項9】 制御電圧によって発振周波数を変化させ る電圧制御発振器において、

外部と電気的に接続するための第1実装用導体電極及び 第2実践用導体電極と、前記第1実装用導体電極のみと 電気的及び特理的に接続されて複数の第1連等体機層と、 前記第2実装用導体電極のみと電気的及び特理的に接続 された複数の第2導電体層と、前記第1及び第2導電体 層間及びその周囲を覆き絶縁層とで構成されるととも に、前記第1導電体層と前記第2導電体層が前記替終層 を挟んで変互に形成された報網セラミックコンテンと、該積層セラミックコンデンサにおける前記第1項及 第2実践用導体電極の形成されていない前記替維層 第2実践用導体電極の形成されていない前記替維層の 第2実践用導体電極の形成されていない前記替維層の 第2実践用導体電極の形成されていない前記替維層の 第2実践用導体電極の形成されていない前記替維層の 第2実践用導体電極の形成されていない前記替維 体電極と電気的及び物理的に接続された抵抗体と、から 成る複合機能電子部品を、

有することを特徴とする電圧制御発振器。

【請求項10】 インダクタンス素子と電圧可変容量素 子とから成る共振回路と、

制御電極に前記共振回路が接続されるとともに直流電圧 でバイアスされた発振用トランジスタと、を有し、

前記発振用トランジスタのエミッタ電極に一端が接続されるとともに並列に接続された抵抗及びコンデンサが、 前記複合機能電子部品によって構成されることを特徴と 大きな大型の1210kg 2010kg 2010kg

前に核音吸能電子前のによって構成されることを特徴とする請求項9に記載の電圧制御発振器。 【請求項11】 制御電圧によって発振周波数を変化さ

せる電圧側例発級器において、 外部と電気的に接続するための第1実装用導体電極及び 第2実装用導体電極と、前記第1実装用導体電極のみと 電気的及び物理的に接続された複数の第1連電体層と、 前記第2実线用導体電極のみと電気的及び物理的に接続 された複数の第2導電体層と、前記第1放ご第2導電体 層間及びその周囲を覆1差線を置とで構成されるととも に、前記第1導電体層と前記第2導電体層が前記絶縁層 を挟んで突互に形成された機層セラミックコンデンサ と、該機器セラミックコンデンサにおける 制記第1 及び 第2実装用導体配を形の形でまれていない前記絶縁層の表 面に、抵抗値の低い導体材料で形成されるととともに、

面に、駄積値の低い場体材料で形成されるととともに、 前記第1及び第2実装用導体電極と電気的及び物理的に 接続されたインダクタンスパターンと、から成る複合機 能電子部品を、

有することを特徴とする電圧制御発振器。

【請求項12】 インダクタンス素子と電圧可変容量素 子とから成る共振回路と、

制御電極に前記共振回路が接続されるとともに直流電圧でバイアスされた発振用トランジスタと、を有し、

前記共振回路を構成するインダクタンス素子と、該イン ダクタンス素子と並列に接続される温度補賃用コンデン サとが、前記機合機能電子部品によって構成されること を特徴とする請求項11に記載の電圧制御発無器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、異なる電気的機能 を有する電子素子が形成された複合機能電子部品、その 製造方法及びそれを備えた電圧制御発振器に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】従来より使用されている電圧側刺発振器の回路構成を、図1に示す。尚、この図1に示す電圧制 類発展器の回路構成については、本発明における電圧制 博発振器の回路構成と同様なので、その構成の詳細な説 明については検述するものとし、以下に簡単に説明す る、図1に示す電圧制御発振器は、可変容量グイオード Dと、インゲクタンス楽于11、L2と、コンデンサC 1. C2. C3, C4とで、共振回路Aが構成される。 又、npn型トランジスタ下1と、コンデンサで5, C 6, C7と、抵抗R1, R2, R3, R4で責性抵抗回路Bが構成される。更に、npn型トランジスタ下2 と、インダクタンス素子L3と、コンデンサC8, C 9, C10, C11と、抵抗R1, R2, R4とで増編回路のが構成される。

【00031 この図1の示される電圧制御を無料は、図のように基板上に各素子を構成する電子部品が実装される。即ち、実装基板4上に、トランジスタ11、T2を1つの電子部品として構成する2トランジスタ11、T2を1つの電子部品として構成する2トランジスタ1バットン型スタ1と、パリキャップグ27 計画3 とが実装されている。この実建基板4上に実装されている。空子部品は、それぞれ、2トランジスタ1パッケージ型トランジスタが1点、パリキャップダイオード2が1点、たり他のチップ電電子部品3が15点となり、全体で17点の電子部品が実装されていることとなる。尚、不図示であるが、インダクタンス素子は、実装基板4上に導電性ペーストを印刷、焼き付けすることで、導体パターンとして挑殴され

【0004】このように、多数の素子より構成される電圧制御発展器において、近年求められ続けている装置の、型化について、この多数の素子を高密度で実装することによって対応している。又、この装置の小型化については、電圧削御長振器以外の分野において、実装する部に複数の機能を持った複合能能品とすることによって、その部品点数を減少させることで対応しているものが、拷開子9-283704号公帳において提案されている。

[0005]

【発助が解決しようとする問題】現在の小型電子部品の高密度実践技術は限界に近づいており、図9のように、17点の本電子部品を実践する基板4の面積は、5.0 mm×4.0 mmが必要となる。そこで、実装する電子部品の大きさ自体を小さくすることも考えられるが、この電子部品の小型化には製造の困難さが伴う。又、実装部品の部品数の削減も、その性能を保持するには限界となっている。

【0006】又、特開平9-283704号公輔のよう 水、抵抗成分と容量成分を持つ複合機能電子部品が提供 されているが、抵抗部分とコンデンサ部分が直列に接続 されるように構成されたものであり、図1の回路構成に あように抵抗部分とコンデンサ部分が並列に接続され たらいへの週用が不可能である。更に、コンデンサ部分 たついて、その容量値を大きくするには、コンデンサ部分 分を形成する前電休膜や電極の面積を広くする必要があ り、半額体基板上に形成される面積が大きくなる。

【0007】更に、電圧制御発振器は、その発振周波数 を調整するために、基板に内装されている導体パターン をレーザーなどで焼きとるトリミングという工程を行い、その主たる原因となるインダクタンス素子の値のバラツキを顕整する必要があった。

【0008】にのような問題を鑑みて、本発明は、複数の異なる電気機能の実装部品を1つの電子部品として構成された機会機能電子部品及びその製造方法と、この核合機能電子部品が搭載されることによって、その基板面積を小さくすることができる電圧制御発振器とを提供することを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、請求項1に記載の複合機能電子部品は、外部を電気 的に接続するための第1実集用導体電極及欠第2実装用 導体電極と、前記第1実集用導体電極のみと電気的及び 物理的に接続された複数の第1導電体層と、前記第2実 装用導体電極のみと電気的及び物理的に接続されて複数 の第2導電体層と、前記第1及び第2導電体層間及びそ の周囲を覆う絶縁層とで構成されるとともに、前記第1 零電体層と前記第2導電体層が記録を使火で交互 に形成された積層セラミックコンデンサと、該積層セラ ミックコンデンサにおける前記第1次第2実装用導体 電極の形成をれていない前記地縁層の表面に形成され ととともに、前記第1及び第2実装用導体電極と電気的 及び物理的に接続された抵抗体と、を有することを特徴 とする。

【0010】このような複合機能電子部品において、銀 や銀パラジウムなどの導電体材料によって形成される第 1及び第2導電体層を、その間に酸化チタンや酸化バリ ウム及び酸化鉛などの絶縁材料を混合したガラスセラミ ック材料で形成された絶縁層を挟んで形成することで、 容量部分を形成する。この容量部分の両側に、第1導電 体層と電気的及び物理的に接続された第1実装用導体電 極と、第2導電体層と電気的及び物理的に接続された第 2実装用導体電極とを設ける。又、この容量部分は、第 1及び第2実装用導体電極が接続される面以外の面が、 絶縁層で覆われており、この絶縁層の表面に、第1及び 第2実装用導体電極と電気的及び物理的に接続するよう に、酸化ルテニウムなどの抵抗体材料によって抵抗体が 形成される。このようにして、第1及び第2実装用導体 電極間に、並列に接続された抵抗部分及び容量部分を有 する複合機能電子部品となる。

【0011】又、このようた複合機能電子都品において、請求項2に記載するように、前述役合機能電子部品の形状を 直方体形状とし、対向する 2 面に前記第1及び第2 実装用導体電極が形成された2 面以外の 4 面のうちの少なくとも1 面の前記機서層の表面に、前記抵抗体が形成されたまました。

【0012】請求項3に記載の複合機能電子部品の製造 方法は、抵抗機能と容量機能を有する複合機能電子部品 の製造方法において、第1 導電体層と第2 等電体層の間 及びその周囲に絶縁層が形成されるように、前記第1及 近第2 準確一限及い前記総略が順に積層された後、周 囲に形成された前記絶縁層の表面上に抵抗体が形成さ れ、前記第1 導電体層及が前記抵抗体に電気的反び物理 的に接続されるように、外部と電気的に接続するための 第1 実装用車体電極が形成されるとともに、前記第2 導 電体層及び前記抵抗体に電気的及び物理的に接続される ように、外部と電気的及び物理的に接続される ように、外部と電気的を対象型表現 電体層及が前記抵抗体に電気的及び物理的に接続される ように、外部と電気的と接続するための第2 実装用導体 電極が形成されることを特徴とする。

【0013】このようにすることで、従来のように、絶 終層と導電体層とを交互に形成して容量部を形成した 後、表面の機器層に抵抗体材料をスクリーン印刷法など でパターン形成して抵抗体を形成する。そして、このよ うに抵抗痛とこる抵抗体が形成する。そして、このよ うに抵抗痛とこる抵抗体が形成された容量部の側面の対 向する2面に実装用導体電影を銀ペーストに半田メッキ を施して接続することで、第1導電体層及び抵抗体を第 工業共用操作電極に電気的及び物理的に第2 実装用操体電極に電気的及び物理的に第2 実装用操体に接触する。

【0014】X、請求項4に記載するように、前記機合機能電子部品が形成された後、前記被合機能電子部品が下ドックンスが測定され、測定したアドミックンスの実験値より抵抗部分の抵抗値が検出されるとともに、測定したアドミックンスの虚数値より容量部分の容量値が検出されるようにしても構わない。

(0016)このような複合機能電子部品において、銀 や銀パラジウムなどの導電体材料によって形成される第 1及び第2導電体層を、その間に酸化チタンや酸化パリ ウム及び酸化鉛などの絶縁材料を混合したがラスセラミ ック材料で形成された絶縁層を挟んで形成することで、 発量給分を形成する。この管塞計分両側に、第1導電 体層と電気的及び物理的に接続された第1実装用導体電 極と、第2導電体層と電気的及び物理的に接続された第2 実装用導体電極とを設ける、又、この容量が分は、第 1 及び第2契殻用導体電極が接続される面以外の面が、 絶縁層で覆われており、この絶縁層の表面に、第1及び 第2実装用導体電極と電気的及び物理的に接続するよう に、銀や銀パラジウムなどの夢電体材料によってインダ クタンスパターンが形成される、このようにして、第1 及び第2実装用導体電極間に、並列に接続されたインダ クタンス部分及び容量部分を有する複合機能電子部品と なる。

【0017】又、このようを被合機能電子部品において、請求項6に記載するように、前記役合機能電子部品の形状を、庭方体形状とし、対向する2回に前記第1及び第2実装用導体電極が形成された2回以外の4回のうちの少なくとも1回の前記絶縁層の表面に、前記インダクタンスパターンが形成されるようにしても構わない。

【0018]請求項7に記載の複合機能電子部品の製造方法は、抵抗機能と容量機能を有する複合機能電子部品の製造方法は、抵抗機能と容量機能を有する複合機能電子部の思数さがたいて、第1車等体層を第2車等体層の関及びその周囲に絶縁層が形成されるように、前記第1及び第2準電体層及び前記絶縁層が順に積層された後、抵抗率の低い環体材料によって、周囲に形成された後、抵抗率の低い環体材料によって、周囲に形成された後、抵抗率の低い環体材料によった、周囲に形成された後、抵抗等の低い地域があるように、外部電電気がに接続するための第1実装用導体電極が形成されるととも、前距解2車端体層及が前型に分クタクンスパターンに電気的及び物理的に接続されるように、外部と電気的に接続するための第2実装用導体電極が形成されることを特徴とするとのの第2実装用導体電極が形成されることを特徴とする。

【0019】このようにすることで、従来のように、絶縁限と等電休局とを交互に形成して容量縮を形成した 縁限 表面の発展に線ペーストなどをスクリーン印刷法 などでパターン形成してインダクタンスパターンを形成 する。そして、このようにインダクタンス素子部となる インダクタンスパターンが形成された容量がの間面の対 向する2面に実装用導体電極を銀ペーストに半田メッキ を施して接続することで、第1導電機で取びパヤ型の シスパターンを第1実装用等体電極に電気的変化物理的 に接続するとともに、第2導電体階及びインダクタン パターンを電気的及び物理的に第2実装用導体電極に接 彼する。

【0020】又、請求項8に記載するように、前記複合 機能電子部品が形成された後、前記複合機能電子部品の 共振周波数が測定されるようにしても構わない。

【0021】請求項9に記載の電圧制御発振器は、制御 電圧によって発振用波数を変化させる電圧制御発振器に おいて、外部と電気的に接続するための第1実短用導体 電極及び第2実整用導体電極と、前記第1実提用導体 個のみと電気的及び物理物に接続された複数の第1導電 体槽と、前記第2実差用導体電極のみと電気的及び物理 的に接続された複数の第2簿電体層と、前記第1及び第 2簿電体開間及びその問囲と覆う絶縁層とで構成される とともに、前記第1 導電体局を前記第2簿電機関が前記 絶縁層を挟んで交互に形成された積層セラミックコンデ ンサと、該積層セラミックコンデンサにおける前記第1 及び第2実装用導体電極の形成されていない前記総層 の表面に形成されるととともに、前記第1及び第2実装 用導体電極と電気的及び範囲的に接続された抵抗体と、 から成る複合機能電子部品を、有することを特徴とす る。

【0022】請求項10に記載の電圧制御発振器は、請

求項9に記載の電圧制御発振器において、インダクタン ス素子と電圧可変容量素子とから成る共帰回路と、制御 電極に前記共振回路が接続されるとともに直流電圧でバ イアスされた発振用トランジスタと、を有し、前記発振 用トランジスタのエミッタ電極に一端が接続されるとと もに並列に接続された抵抗及びコンデンサが、前記複合 機能電子部品によって構成されることを特徴とする。 【0023】請求項11に記載の電圧制御発振器は、制 御電圧によって発振周波数を変化させる電圧制御発振器 において、外部と電気的に接続するための第1実装用道 体電極及び第2実装用導体電極と、前記第1実装用導体 電極のみと電気的及び物理的に接続された複数の第1導 電体層と、前記第2実装用導体電極のみと電気的及び物 理的に接続された複数の第2導電体層と、前記第1及び 第2導電体層間及びその周囲を覆う絶縁層とで構成され るとともに、前記第1導電体層と前記第2導電体層が前 記絶緩層を挟んで交互に形成された積層セラミックコン デンサと、該積層セラミックコンデンサにおける前記第 1及び第2実装用導体電極の形成されていない前記締縁 層の表面に、抵抗値の低い導体材料で形成されるととと もに、前記第1及び第2実装用導体電極と電気的及び物

[0024] 請求項12に記載の電圧制御発振器は、請 求項11に記載の電圧制御発振器において、イングクタ ンス業子と電圧可変容量素子たから成る共振回路と、制 側電額に前記共振回路が接続されるとともに直流電圧で バイアスされた発振用トラシジスタと、を有し、前記共 振回路を構成するイングクタンス素子と、該インダクタ ンス素子と並列に接続される温度補償用コンデンサと が、前記社合機能電子部品によって構成されることを特 物とする。

理的に接続されたインダクタンスパターンと、から成る

複合機能電子部品を、有することを特徴とする。

[0025]

【発明の実験の形態】<電圧制御発振器の回路構成>本 毎明の電圧制御発振器は、従来より使用されている電圧 制御発展器と同様、図1に示す回路構成となる。図1に 示す電圧制御発振器は、一端に制御電圧VTが印加され るインダクタンス業子し1及びコンデンサで11と、イン ダクタンス業子上1の他職にフルード側が増発すれると ともにアノード側が接地された可変容量ダイオードD と、インダクタンス業子L1と可変容量ダイオードDの カソード側との接続ノードに一端が接続されたコンデン サC2と、このコンデンサC2の他場に一端が接続され るとともに地端が接地されたインダクタンス業子L2及 びコンデンサC3と、コンデンサC2、C3の接続ノー ドに一端が接続されたコンデンサC4とが設けられ、共 棚回路入が構成される。

【0026】この共振回路Aにおいて、可変容量ゲイオードDの容度値を制御するための電圧を与えるために、 インダクタンス素子し1とコンデンサで12 でローパス マルタを構成される。又、入グ4ストリップライン共 振器からなるインダクタンス素子し2と、遺転補償用素 そとなるコンデンサイ3と、可容容量ゲイオードDとで 並列共振回路が精成される。又、コンデンサC4によっ て、後段の回路への直流成分の入力を防ぐ。尚、コンデ シサC10倍減が移触される。又

[0027]コンデンサC4の他端に接続されて共振回路 かちの電圧がベースに与えられる n p 型トランジ スタT1と、トランジスタT1のベース・エミック間に接続されたコンデンサC5と、トランジスタT1のベース・スピー端が接続されたは、R2と、トランジスタT1のエミックに一端が接続されるとともに他端が接地されたコンデンサC6及び抵抗R3と、トランジスタT1のコレクタC-- 畑が経統日るとともに他等が接地されたコンデンサC7と、一端が抵抗R2の他端に接続された抵抗R4とによって、負性抵抗回路 Bが構成される。尚、抵抗R4に1の他端が接触される。尚、抵抗R4に1の他端が接触される。

【0028】更に、抵抗R1、R2、R4と、抵抗R2の他郷にベースが接続されるとともにトランジスタ下1のコレクタにエミックが接続されたロpn型トランジスタ下2と、トランジスタ下2のコレクタに一端が接続されたコンデンサC9、C10及びイングクタンス素子L3と、イングクタンス素子L3の他端に一端が接続されたコンデンサC11とによって、増幅回路とが構成されたコンデンサC9、C11の他端が接続されたコンデンサC9、C11の他端が接続され、又、抵抗R4の他端がイングクタンスL3の他端に接続

X、抵抗R4の他職がインタクタンスし3の他場に接続 される。更に、抵抗R4、インダクタンス素子L3、コ ンデンサC11の接続ノードには、バイアス電圧VDが 印加される。

【0029】このように構成されるとき、負性抵抗回路 的が無期間熱と発振条件を禁むした周波数を安定して 出力するとともに、増福回路Cは負性低抗回路Bととも にコルビッツ型の発振用能物回路として動作することに って、負性低抗回路の分乗係信号を増幅する。そし て、このようにして増幅された発掘信号は、コンデンサ ご10によって直流成分が除去された信号として、コン デンサC10の他場に接続された出力場子のUTより出 力される、このとき、トラシジスタ下10分乗用のよ シジスタとして動作するととは、トラシジスタア12が 増幅用のトランジスタとして動作する。

【0030】図1に示す電圧制御発振器は、以下に説明 する各実施形態における電圧制御発振器において共通で ある。よって、以下の各実施形態においては、図1に示 す電圧制御発振器に使用される複合機能電子部品につい て、それぞれ説明する。

【0031】<第1の実施形態>本発明の第1の実施形態について、図面を参照して説明する。図2は、図1の 運圧制御表振器に設けられる抵抗成分と容量成分を有す る複合機能電子部品の構成を示す斜辺因及び等価回路図 である。図3は、図2の複合機能電子部品の断面図であ る。図4は、図2の複合機能電子部品と検査装置との関 係を示すプロック図である。

【0032】図2(a)の外側斜視図に示す複合機能電子部品は、図2(b)の等値回路図に示すように、抵抗 とコンデンサが並列に接続された複機機能電子部品で、図1における抵抗R3とコンデンサC6とを構成するための複合機能電子部品である。図2(a)に示す複合機電子部品は、両側の対向する2面に実装用導体電極22、23が設けられた機関をラミック構造を持つ直方体のチップ型コンデンサ21において、実装用導体電極2、23が設けられて状間といるいて、実装用導体電極2、2、23の形成されていない1面に抵抗体24が形成された構成めらのである。

【0033】この図2(a)のようを複合機能電子部品は、図3の断面図のように、実践用準体電格22にその間面の1面が電気の及び物理的に接続された準体階31日と、実装用導体電格23にその側面の1面が電気的及び物理的に接続された準体階31日と、総縁用セラミックコンデンサであるチップ型コンデンサ21が形成される。この事電体層31a、31日は、銀や銀・プシスセンより変り、又、絶縁用32は、酸化・チンや酸化パリウム及び酸化鉛などの絶縁材料を混合したガラスセラミック材料から成る。このとき、導電体層31aの大学に表していない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。又、寒電体層31日の実装用導体電路23に接続されていない。

[0034] このようにして形成されるチップ型コンデ サウ21の上面に、酸化ルテニウムなどの抵抗体材料に よって、抵抗体24が形成される。このチップ型コンデ ンサ21に形成された抵抗体24が実践用導体電腦2 2、23と電が的及び物理形式・接続されるように、実装 用導体電腦22、23がコの学型に形成される。尚、こ のように抵抗体24が形成された絶縁間32の表面に は、図示していないが、保報競別31の表面に は、図示していないが、保報競別31の表面に は、図示していないが、保報の対けられる。

[0035]図2及び図3のような構成の複合機能電子 部品は、まず、銀や銀パラジウムなどの導体材料とガラ スセラミック材料をスクリーン印刷法などによって積層 するように形成することで、導電休層31a、31b及 び絶縁層32が積層された根層セラミックコンデンサが 形成される。次に、この構成された税層セラミックコリデンサの1面に、抵抗体材料をスタリーン印刷法で印刷 するなどして、抵抗体24を形成する。そして、このように抵抗体24が形成された視層セラミックコンデンサの対向する個面2面に、銀ベストに半田メーを施した実装用導体電艦22、23が接続されることによって、実装再導体電艦22、23が、抵抗体24及び導電 体層31a、31bと電気的に接続される。

【0036】この複合機能電子部品は、図4のように、インビーダンスアナライザといった電子部品のアドミックンスを製定することが可能な、測定装置 41のリード場 7年接続されたリード42、43が、複合機能電子部品40の実装用導体電極22、23に接続されることによって、そのアドミッタンスヤ=G+J×が測定されたとき、その抵抗値が、1/Gで有り、又、その容量値がメ/2πf(前は測定装置41で測定する緊に使用する交流電源の周波数)となる。

【0037】このような複合機能電子部品が取付られた 延圧制御発掘器の実装部品点数は、図5のように、基板 4に実装される2トランジスタ1パッケージ型トランジ スタ1が1点、バリキャップダイオード2が1点、複合 娘能電子部品を含むその他のチップ型電子部品3が14 点となり、全体で16点となる。このとき、各部品同士 の実装調路は、従来と開楼と0.2m即以上確保すること になるが、部品点数を従来よりも1点減少するので、 基板4の基板サイズを4.6mm×4.0mmとすることができる。よって、従来のものの基板サイズと比較し 、略8条程度、その面積を削減するとかできる。

【0038】(第2の実施物限)本発明の第2の実施 態について、図面を専服して認明する。図6は、未実施 形態の電圧制御乗機器に設けられるインダクタンス成分 と容集成分を有する複合機能電子部品の構成を示す解鍵 第48の間回でする。図7は、図6の複合機能電子部品 第48の間回である。図8は、図6の複合機能電子部品 と検査装置との関係を示すプロック図である。尚、図6 及び図7において、図2友び図3の複合機能電子組品 同一の目的で使用する部分については、同一の符号を付 して、その算準化設明は省略する。

【0039】図6(a)の外職料拠図に示す権合機能定 手部品は、図6(b)の零価回路図に示すように、イン グクタンスとコンデンサが並列に接続された複合機能電 干部品で、図1におけるインダクタンス業干12とコン デンサで3とを構成するためが各機能電子部品であ る、図6(a)に示す複合機能電子部品は、両側の対向 する2面に実裁用導体電盤22、23が設けられた積層 セラミック構造を持つ値方体のチップ型コンデンサ21 において、実装用導体電極22、23の形成されて収金 い1面にインダクタシスパタ・ン51が形成された構成 のものである。

【0040】この図6(a)のような複合機能電子部品は、第1の実施形態と同様、図7の断面図のように、実 装用導体電路22にその側面の1面が電気的及び物理的 に接続された導電体層31aと、実装用導体電路23に その側面の1面が電気的及び地質的に接続された導電体 層31bと、絶縁層32とが交互に重ね合わせられるこ とによって、標準でミックコンデンサであるチップ型 コンデンサ21が形成される。

【0041】そして、このようにして形成されるチップ 型コンデンサ21の上面に、銀ペーストなどの導体材料 によって、インダクタンスパターン51が形成される。 このチップ型コンデンサ21に形成されたインダクタン スパターン51が実装円薄体電板22、23と電気的及 び物理的に接続されるように、実装用導体電板22、2 3がコの字型に形成される。尚、このようにインダクタ ンスパターン51が形成された。尚、このようにインダクタ ンスパターン51が形成された。

【0042】図6及び図7のような構成の複合機能電子 部品は、第1の実施形態と同様、まず、銀や銀火ラジウ ルなどの薄体材料とガラスセラシック材料とスクリーン 印刷法などによって積層するように形成することで、導 電炉層31a、31b及び地縁層32が積層された積層 セラミックコンデンサが形成される。次に、の構成さ れた積層セラミックコンデンサの1面に、導体材料をス クリーン印刷法で印刷するなどして、インダクタング ターン51を形成する。そして、このようにインダング サーンが関係での間で1面に、銀ペーストに半田メッキを サーンが対象が観音となって、実生用端体電極22、23が、インダクタンスパターン て、実建用端体電極22、23が、インダクタンスパターン レ大実接続体電極22、23が、インダクタンスパターン で、実建用端体電極22、23が、インダクタンスパターン コン51及び帯電体層31a、31bと電気的に接続さ わる。

【0043】この複合頻能電子部品は、図8のように、 ネットワークアナライザといった電子部品を流れる電流 の無幅を測定することが可能な測定装置81のリード端 子に接続されたリード82、83が、複合機能電子部品 80の実験用導体電極22、23に接続されることによ って、その共振別波数が測定される。即り、後令機能電 子部品80を流れる電流の振幅に対する別波数特性が測 定され、その電流の振幅が小さくなる周波数キ共駒周波 数として検出される。

【0044】このように共転開液数が制定された指金機能電子部品が、定圧制御発振器の共振回路へのインダククンス素子上2とコンデンサウこ3とを構成する部分に実装されることによって、電圧制御発振器で使用する発展、同波数に応じた間波数特をする主候回回各権成することができる。又、この電圧制御発振器の発振開波数を変更する場合には、その共振用波数の異なる複合機能なるで対抗することによって対応することができるの

で、従来のように、インダクタンスパターンの導体器を 消失して関波数調整する工程が不要とすることができ、 簡易に関波数調整を行うことができる。更に、従来のようなインタクタンスパターンを、他の電子端貼が実装さいる基盤はと設ける必要がなくなるので、このインダク タンスパターンが設けった大変接面分、その基板面積を 削減することができる。

1004年)高、図1に示す電圧制御発展器に払いて、 第1及び第2の実維形態にで説明した複合機能電子部品 両方が実装されるようにしても構わない。このようにし て構成することで、電圧制御発展器が構成される基板の 面積を更に縮かすることができ、電圧制御経展器を更に 小型化することが可能となる、スー本専門の冷機能電 子部品は、第1、第2の実施形態の形状に限定されるも のでなく、例えば、チップ型コンデンサの複縁配におけ を他の表間に振体は入ばインタクランスパターンが形成 されるものや、チャブ型コンデンサの複数の連結解表 に抵抗体スはインダクタンスパターンが形成されるもの でも構みない。

# [0046]

【発明の効果】本発明によると、従来のチップ型コンテンサの絶極間の表面に抵抗体又はインサクタシスパター シを構成することによって、第1及び第2要法制等体電 格面に容量成分と抵抗成分とが差列に表域された複合機能電 子部品を構成することができる。よって、性外のチップ 型コンデンサと、その大きさがは迂回等の複合機能電子 部品とすることができるため、各種回路と構成する際に 実装される基度面積を縮っている。

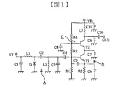
【0047】ス、容量成分とインテクタンス成分とが並 利に接続された複合機能電子部品を電圧削算発展器に用 いたとき、この複合機能電子部品の共振開波数を子が測 定することが可能であるので、従来のように、インダク タンスパターンをレーザー照算などで消失させて周波数 

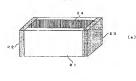
#### 【関節の簡単な説明】

- 【図1】 電圧制御発振器の構成を示す回路図。
- 【図2】第1の実施形態の複合機能電子部品の構成を示す外観斜視図及び等値回路図。
- 【関3】第1の実施形態の複合機能電子部品の内部構成 を示す断面図。
- 【図4】第1の実施形態の複合機能電子都品と測定器と の関係を示す図。
- 【図5】第1の実施形態の複合機能電子部品を実装した 基板実装面における電子部品の配置図。
- 【図6】第2の実施形態の複合機能電子都品の構成を示す外観鏡視型及び等値回路図。
- 【図7】第2の実施形態の複合機能電子部品の内部構成 を示す断面図。
- 【図8】第2の実施形態の複合機能電子部品と測定器と の関係を示す図。
- 【図9】 従来の電圧制御発展器を構成する電子部品を実 装した基板実装面における電子部品の配置図。

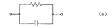
#### 【特号の説明】

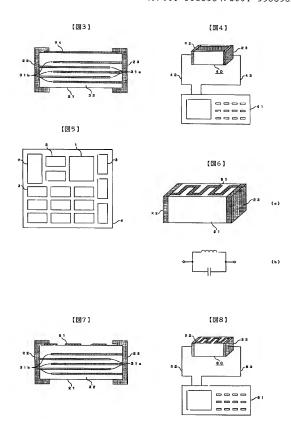
- 1 2トランジスタ1パッケージ型トランジスタ
- 2 バリキャップダイオード
- 3 チップ型電子部品
- 4 実験基板
- 21 チップ型コンデンサ
- 22、23 実践用導体電極
- 24 抵抗体
- 31a,31b 養電体層
- 3 2 絶縁蘭
- 51 インダクタンスパターン





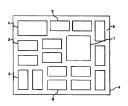
【图2】





.





# フロントページの続き

(51) Int. Cl.7		識別記号	FΙ			(参考)
H01G	4/30	301	H 0 3 B	5/04	C	5J081
		311		5/12	G	
H03B	5/04		H03H	5/02		
	5/12			7/06		
нозн	5/02		H01G	4/40	307A	
	7/06		H01F	15/00	D	
			H01G	4/40	321A	

## Fターム(参考) 5E001 AB03 AC10 AH01 AJ01 AJ02

AJ03

5E033 AA27 BB02 BC01 BD01 BG02

5E070 AA05 AB01 AB02 BA12 CB03

**CB12** 

5E082 AA01 AB03 BC39 DD02 DD08

DD11 EE04 EE11 EE23 EE35

FF05 FG06 FG26 KK08 LL15 5J024 AA01 CA03 DA04 DA29 DA31

DA32 EA05

5J081 AA03 AA11 CC43 DD03 DD21

EE02 EE03 EE09 EE18 GG05